



PCT

特 許 協 力 条 約



503P872

国際調査報告

(法 8 条、法施行規則第40、41条)
〔PCT 18条、PCT規則43、44〕

出願人又は代理人 の書類記号 JS0NY-384PCT	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JPO3/09602	国際出願日 (日.月.年) 29.07.03	優先日 (日.月.年) 30.07.02	
出願人 (氏名又は名称) ソニー株式会社			

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT 18条)の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 4 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された磁気ディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☐ 出願人が提出したものを承認する。

☒ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、

第 1A 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。

☐ なし

☐ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

第Ⅲ欄 要約 (第1ページの5の続き)

低誘電率層間絶縁膜内にデュアルダマシン多層配線構造を形成する半導体装置の製造方法である。第一の絶縁膜(6)及び第二の絶縁膜(7)を成膜し、次いで第一から第三マスク形成層(8)、(9)、(20)を成膜する。第三マスク形成層をパターンニングして配線溝パターンの第3のマスクを形成する。第3のマスクを含む第二マスク形成層上に接続孔パターンのレジストマスクを形成し、第3のマスク、第二及び第一マスク形成層をエッチングし、更に第二の絶縁膜をエッチングする。第3のマスクを用いて配線溝パターンの第2のマスクを形成すると共に、第一の絶縁膜の途中まで接続孔を開口する。第2のマスクを用いて第一マスク形成層をエッチングし、配線溝パターンの第1のマスクを形成すると共に、接続孔の底部に残存する第一の絶縁膜をエッチングして接続孔を開口する。第1ないしは第2のマスクを用いて、第二の絶縁膜に配線溝を形成する。